

图书基本信息

书名：<<模拟/射频集成电路设计的晶体管级建模>>

13位ISBN编号：9787030182418

10位ISBN编号：7030182413

出版时间：2007-1

出版时间：科学出版社

作者：格宾斯基

页数：293

字数：481000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

器件的模型一直是模拟 / 射频集成电路工程师关心的问题。是否能建立一个尽可能反映器件行为的模型关系到整个集成电路设计的成败。本书内容丰富，从主流模型的讨论到小尺寸器件模型和量子效应的介绍，从模型参数的提取方法到模型在硬件描述语言中的应用等方面都作了详细的论述。本书对设计工程师和器件工程师都有很好的参考价值。

书籍目录

Foreword Hiroshi Iwai Introduction Wlodek Grabinski, Bart Nauwelaers and Dominique Schreurs
1 2/3-D process and device simulation. An effective tool for better understanding of internal behavior of semiconductor structures Daniel Donoval, Andrej Vrbicky, Ales Chvala, and Peter Beno
2 PSP: An advanced surface-potential-based MOSFET model R. van Langevelde, and G. Giltenblat
3 EKV3.0: An advanced charge based MOS transistor model. A design-oriented MOS transistor compact model for next generation CMOS Matthias Bucher, Antonios Bazigos, Francois Krummenacher, Jean-Michehl Sallese, and Christian Enz
4 Modelling using high-frequency measurements Dominique Schreurs
5 Empirical FET models Iltcho Angelov
6 Modeling the SOI MOSFET nonlinearities. An empirical approach B. Parvais, A. Siligaris
7 Circuit level RF modeling and design Nobuyuki Itoh
8 On incorporating parasitic quantum effects in classical circuit simulations Frank Felgenhauer, Maik Begoin and Wolfgang Mathis
9 Compact modeling of the MOSFET in VHDL-AMS Christophe Lallement, Francois Pecheux, Alain Vachoux and Fabien Pregaldiny
10 Compact modeling in Verilog-A Boris Troyanovsky, Patrick O'Halloran and Marek Mierzwinski
Index

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>